

FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS :

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)					電 氣 的 特 性 (Ta=25°C)										外 形	備 考
				V _{CEO} (V)	V _{CEO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CEO} 最大値 (μA)	V _{CB} (V)	直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{FE}	h _{ie}	h _{ie} *	h _{FE} *		
1	2	3	4	5					6		7		8			9	10		11	12

- 1** TYPE NUMBER
- 2** ORIGINAL MANUFACTURER
- 3** USES
- 4** MATERIAL AND STRUCTURE
- 5** MAXIMUM RATINGS
- 6** I_{CEO} MAXIMUM VALUE AND V_{CB} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{CEO})
- 7** STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{CE}, I_C (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})
- 8** STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{CB}, I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

- 9** f_{αb} OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T.
- 10** C_{ob} AND r_{bb'} OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN r_{bb'} COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (real)
- 11** OUTLINE
- 12** REMARKS

: とコンプリ : COMPLEMENTARY TO

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)														外 形	備 考
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CBO} 最大値		直 流 又 は パ ル ス h_{FE}			バ イ ア ス		h_{fe} h_{fb}^*	h_{ie} h_{ib}^* (Ω)	h_{re} h_{rb}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{ob}^* (μU)	f_{β} f_T^* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $r_{bb'}^*$ (Ω)		
									μA	V_{CB} (V)	V_{CE} (V)	I_C (mA)	V_{CB} (V)	I_E (mA)	V_{CE} (V)									
2SC1901	富士通	RF	Si.EP	25	3	20	200	175	0.1	12	150	8	5						1400*	1.2	40*	84C		
" 1902	"	"	"	40	3	300	500	175	0.1	35	80	14	55						650*	2.8	25*	84C		
" 1903	"	AF.RF	"	150	5	50	1 W	150	1	140	150	5	10	5	-10				130*	2	70*	328		
" 1904	"	"	"	150	5	50	1 W	150	1	140	150	5	10	5	-10				130*	2	70*	328		
" 1905	松下	PA	Si.TP	350	7	200	15W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	300	100	10	50	30	-20				45*	7.5	10	268		
" 1906	日立	RF.Conv.	Si.EP	30	2	50	300	125	0.5	10	>40	10	10	10	-10	$V_{OSC} = 550\text{mV}$ ($f=275\text{MHz}$, $V_{CE}=9\text{V}$, $I_C=7\text{mA}$)			1000*	1	$C_{rbb'}$ 10pS	138		
" 1907	"	Osc.RF	"	30	2	50	300	125	0.5	10	>40	10	10	10	-10	$V_{OSC} = 630\text{mV}$ ($f=930\text{MHz}$, $V_{CB}=10\text{V}$, $I_C=10\text{mA}$)			1100*	1	$C_{rbb'}$ 10pS	138		
" 1908	ソニー	RF	Si.E	30	4	30	500	120	1	25	80	6	1	6	-1				200*	2	$C_{rbb'}$ 25pS	138	2SA925 とコンプリ	
" 1909	日電	PA	"	75	4	3 A	10W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	40	60	10	500	10	-150	$P_o = 5.5\text{W}$ ($f=27\text{MHz}$, $V_{CC}=12\text{V}$, $P_i=0.2\text{W}$)			160*	50	4	268		
" 1910	東芝	Diff	Si.EP	15	2	80	200/unit	175	0.1	5	75	3	50	5	-30	$\Delta V_{BE} < 30\text{mV}$, $\gamma \Delta V_{BE} < 0.2\text{mV}/^\circ\text{C}$ (3 V, 50mA)			7000*	1.1	15*	282A		
" 1911	"	"	"	20	2	30	150/unit	175	0.1	10	80	5	10	5	-10	$\Delta V_{BE} < 15\text{mV}$, $\gamma \Delta V_{BE} < 0.1\text{mV}/^\circ\text{C}$ (5 V, 10mA)			6500*	0.66	15*	282A		
" 1912	"	"	"	20	2	30	150/unit	175	0.1	10	80	5	10	5	-10	$\Delta V_{BE} < 15\text{mV}$, $\gamma \Delta V_{BE} < 0.1\text{mV}/^\circ\text{C}$ (5 V, 10mA)			6500*	0.66	15*	282B		
" 1913	松下	RF	"	150	5	1 A	15W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	130	150	10	150	10	-50				120*	20	3k	268		
" 1914	三菱	AF.RF	"	90	5	50	200	125	0.1	50	250~1200	6	1	6	-1				150*	1.8		138B		
" 1915	"	"	"	120	5	50	800	135	1	100	150~800	10	10	10	-10				200*	2.3		242	2SA905 とコンプリ	
" 1916																								
" 1917																								
" 1918																								
" 1919	三菱	LN	Si.EP	50	5	30	200	125	0.1	50	250~1200	6	1	6	-1	$NF=0.9\text{dB}$ (6V, 100 μA , 10Hz)			150*	1.9		138B		
" 1920	東芝	Diff	"	15	2	80	200/unit	175	0.1	5	75	3	30	5	-30	$\Delta V_{BE} < 30\text{mV}$, $\gamma \Delta V_{BE} < 0.2\text{mV}/^\circ\text{C}$ (3 V, 50mA)			7000*	1.1	15*	282B		
" 1921	日立	RF	Si.T	250	5	50	600	150	1	120	30~300	6	10	6	-10				130*	3	25*	251		
" 1922	"	SW	"	1500	6	2.5A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	600				5	-400	$t_f < 1 \mu\text{S}$			5*	90	15	102	水平偏向用	
" 1923	東芝	RF.Conv. Mix.Osc	Si.EP	40	4	20	100	125	0.5	18	40~200	6	1	6	-1	$NF=2.5\text{dB}$ (100MHz)			550*	C_{re} 0.7	$C_{rbb'}$ <30pS	138		
" 1924	日電	Diff.SW	Si.E	20	3	50	300	200	0.1	10	30~300	5	10	5	-15				3000*	C_{re} 1.1		309B	2素子複合	
" 1925	"	"	"	20	3	50	300	200	0.1	10	30~300	5	10	5	-15	$h_{FE1}/h_{FE2} = 0.8 \sim 1.0$ $\Delta V_{BE} < 10\text{mV}$ (5V, 10mA)			3000*	C_{re} 1.1		309A	2素子複合	
" 1926	"	"	"	30	3	50	200/unit	200	0.05	15	80	10	10	10	-10	$h_{FE1}/h_{FE2} = 0.8 \sim 1.0$			2000*	C_{re} 1.1		309B	2素子複合	
" 1927	"	"	"	30	3	50	300	200	0.05	15	80	10	10	10	-10				2000*	C_{re} 1.1		309A	2素子複合	
" 1928																								
" 1929	松下	PA	Si.P	300	6	400	25W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	300	150	5	100	10	-100				80*	12	15	268		
" 1930	富士通	RF	Si.EP	16	3	30	150	175	0.1	10	80	3	10	6	-20				8000*	0.3	30*	284		